

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **2003-045820**
 (43)Date of publication of application : **14.02.2003**

(51)Int.CI.

H01L 21/268
B23K 26/06
B23K 26/08
G02F 1/1368
H01L 21/20
H01L 21/28
H01L 21/336
H01L 29/786
// G09F 9/00
B23K101:40

(21)Application number : **2001-228832**

(71)Applicant : **SEMICONDUCTOR ENERGY LAB CO LTD**

(22)Date of filing : **30.07.2001**

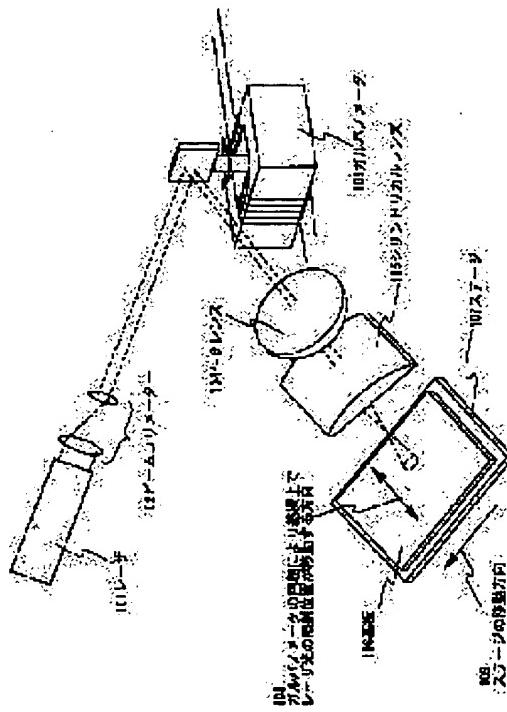
(72)Inventor : **TANAKA KOICHIRO**

(54) LASER IRRADIATION APPARATUS, AND METHOD, AND METHOD OF MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a laser irradiating method and an apparatus which can form a crystalline semiconductor film having crystallinity close to that of a single crystal efficiently even if the area of a substrate is large, and to provide a method of manufacturing a semiconductor device, which includes the laser irradiation method.

SOLUTION: This laser irradiation apparatus has a laser, a means 1 which transfers an application position of a laser beam on a laser application plane in a first direction or a second direction opposite to the first direction, a means 2 which makes the shape of the laser beam elliptical or rectangular, and a stage which moves at least in the second direction.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

[examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-45820

(P 2 0 0 3 - 4 5 8 2 0 A)

(43) 公開日 平成15年2月14日 (2003. 2. 14)

(51) Int. Cl. 7

H01L 21/268
B23K 26/06
26/08

G02F 1/1368

識別記号

F I

H01L 21/268
B23K 26/06
26/08

G02F 1/1368

テマコード (参考)

J 2H092
E 4E068
B 4M104
D 5F052

5F110

審査請求 未請求 請求項の数18 O L (全21頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号

特願2001-228832 (P 2001-228832)

(22) 出願日

平成13年7月30日 (2001. 7. 30)

(71) 出願人 000153878

株式会社半導体エネルギー研究所
神奈川県厚木市長谷398番地

(72) 発明者 田中 幸一郎

神奈川県厚木市長谷398番地 株式会社半
導体エネルギー研究所内

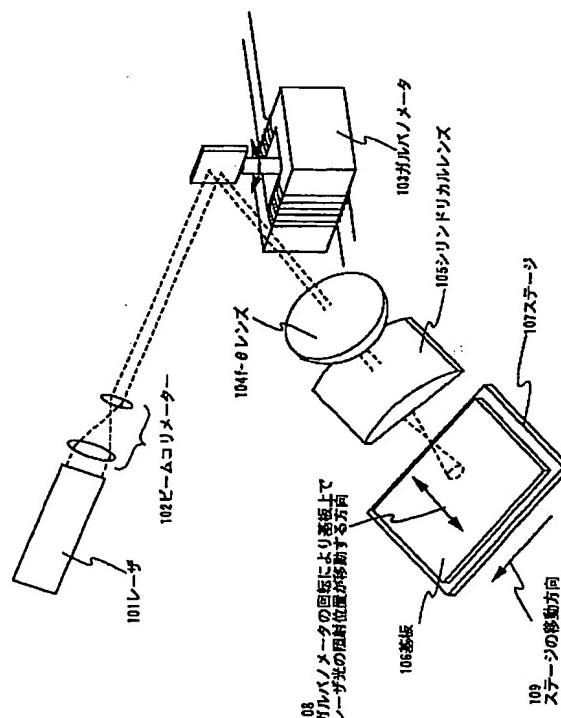
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】レーザ照射装置およびレーザ照射方法、並びに半導体装置の作製方法

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、大面積基板においても、単結晶に近い結晶性を有する結晶質半導体膜を効率よく形成するためのレーザ照射方法およびその装置を提供することを課題とする。また、前記レーザ照射方法を工程に含む半導体装置の作製方法を提供することを課題とする。

【解決手段】 本明細書で開示するレーザ照射装置に関する発明の構成は、レーザと、照射面におけるレーザ光の照射位置を第1の方向または第1の方向とは逆方向へ移動させる手段1と、前記照射面における前記レーザ光の形状を機能状態または矩形状にする手段2と、少なくとも第2の方向に動くステージとを有することを特徴としている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 レーザと、照射面におけるレーザ光の照射位置を第1の方向または第1の方向とは逆方向へ移動させる手段1と、前記照射面における前記レーザ光の形状を楕円状または矩形状にする手段2と、少なくとも第2の方向に動くステージと、を有することを特徴とするレーザ照射装置。

【請求項2】 レーザと、照射面におけるレーザ光の照射位置を第1の方向または第1の方向とは逆方向へ移動させる手段1と、前記照射面における前記レーザ光の形状を楕円状または矩形状にする手段2と、少なくとも第2の方向に動き、かつ、前記レーザ光に対して斜めに設置されたステージと、を有することを特徴とするレーザ照射装置。

【請求項3】 請求項1または請求項2において、前記レーザは、連続発振またはパルス発振の固体レーザであることを特徴とするレーザ照射装置。

【請求項4】 請求項1乃至3のいずれか一項において、前記レーザは、連続発振またはパルス発振のYAGレーザ、YVO₄レーザ、YLFレーザ、YAlO₃レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ti:サファイアレーザから選ばれた一種または複数種であることを特徴とするレーザ照射装置。

【請求項5】 請求項1または請求項2において、前記レーザは連続発振またはパルス発振のエキシマレーザArレーザ、Krレーザから選ばれた一種または複数種であることを特徴とするレーザ照射装置。

【請求項6】 請求項1または請求項2において、前記手段1は、ガルバノメータまたはポリゴンミラーを有することを特徴とするレーザ照射装置。

【請求項7】 請求項1または請求項2において、前記手段1は、ガルバノメータまたはポリゴンミラーおよびf-θレンズを有することを特徴とするレーザ照射装置。

【請求項8】 請求項1または請求項2において、前記手段2は、シリンドリカルレンズを有することを特徴とするレーザ照射装置。

【請求項9】 レーザからレーザ光を発振し、シリンドリカルレンズにより照射面における前記レーザ光の形状を楕円状または矩形状にし、ガルバノメータまたはポリゴンミラーにより前記レーザ光の照射位置を移動させながら前記照射面に照射することを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項10】 レーザからレーザ光を発振し、シリンドリカルレンズにより照射面におけるレーザ光の形状を楕円状または矩形状にし、ガルバノメータまたはポリゴンミラーにより前記レーザ光の照射位置を移動させ、かつ、前記レーザ光を前記照射面に対して斜めに照射することを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項11】 請求項9または請求項10において、

10 前記レーザとして、連続発振またはパルス発振の固体レーザを用いることを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項12】 請求項9乃至11のいずれか一項において、前記レーザとして、連続発振またはパルス発振のYAGレーザ、YVO₄レーザ、YLFレーザ、YAlO₃レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ti:サファイアレーザから選ばれた一種または複数種を用いることを特徴とするレーザ照射方法。

【請求項13】 請求項9または請求項10において、前記レーザとして、連続発振またはパルス発振のエキシマレーザArレーザ、Krレーザから選ばれた一種または複数種を用いることを特徴とするレーザ照射方法。

20 【請求項14】 絶縁表面上に半導体膜を形成し、レーザからレーザ光を発振し、シリンドリカルレンズにより前記半導体膜における前記レーザ光の形状を楕円状または矩形状にし、ガルバノメータまたはポリゴンミラーにより前記レーザ光の照射位置を移動させながら前記半導体膜に照射することを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項15】 絶縁表面上に半導体膜を形成し、レーザからレーザ光を発振し、シリンドリカルレンズにより前記半導体膜における前記レーザ光の形状を楕円状または矩形状にし、ガルバノメータまたはポリゴンミラーにより前記レーザ光の照射位置を移動させ、かつ、前記レーザ光を前記照射面に対して斜めに照射することを特徴とする半導体装置の作製方法。

30 【請求項16】 請求項14または請求項15において、前記レーザとして、連続発振またはパルス発振の固体レーザであることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【請求項17】 請求項14乃至16のいずれか一項において、前記レーザとして、連続発振またはパルス発振のYAGレーザ、YVO₄レーザ、YLFレーザ、YAlO₃レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ti:サファイアレーザから選ばれた一種または複数種を用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。

40 【請求項18】 請求項14または請求項15において、前記レーザとして、連続発振またはパルス発振のエキシマレーザArレーザ、Krレーザから選ばれた一種または複数種を用いることを特徴とする半導体装置の作製方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明はレーザ光を用いた半導体膜のアニール（以下、レーザアニールという）の方法およびそれを行うためのレーザ照射装置（レーザと該レーザから出力されるレーザ光を被処理体まで導くための光学系を含む装置）に関する。また、前記レーザアニ

ールを工程に含んで作製された半導体装置の作製方法に関する。なお、ここでいう半導体装置とは、半導体特性を利用することで機能しうる装置全般を指し、液晶表示装置や発光装置等の電気光学装置及び該電気光学装置を部品として含む電子装置も含まれるものとする。

【0002】

【従来の技術】近年、ガラス等の絶縁基板上に形成された半導体膜に対し、レーザアニールを施して、結晶化させたり、結晶性を向上させる技術が広く研究されている。上記半導体膜には珪素がよく用いられる。本明細書中では、半導体膜をレーザ光で結晶化し、結晶質半導体膜を得る手段をレーザ結晶化という。

【0003】ガラス基板は、従来よく使用されてきた合成石英ガラス基板と比較し、安価で加工性に富んでおり、大面積基板を容易に作製できる利点を持っている。これが上記研究の行われる理由である。また、結晶化に好んでレーザが使用されるのは、ガラス基板の融点が低いからである。レーザは基板の温度を余り上昇させずに、半導体膜のみ高いエネルギーを与えることが出来る。また、電熱炉を用いた加熱手段に比べて格段にスループットが高い。

【0004】結晶質半導体は多くの結晶粒から出来ているため、多結晶半導体膜とも呼ばれる。レーザアニールを施して形成された結晶質半導体膜は、高い移動度を有するため、この結晶質半導体膜を用いて薄膜トランジスタ（TFT）を形成し、例えば、1枚のガラス基板上に、画素部用と駆動回路用のTFTを作製する、アクティブマトリクス型の液晶表示装置等に盛んに利用されている。

【0005】しかしながら、レーザアニール法で作製される結晶質半導体膜は複数の結晶粒が集合して形成され、その結晶粒の位置と大きさはランダムなものであった。ガラス基板上に作製されるTFTは素子分離のために、前記結晶質半導体を島状のパターニングに分離して形成している。その場合において、結晶粒の位置や大きさを指定して形成する事はできなかった。結晶粒内と比較して、結晶粒の界面（結晶粒界）は非晶質構造や結晶欠陥などに起因する再結合中心や捕獲中心が無数に存在している。この捕獲中心にキャリアがトラップされると、結晶粒界のポテンシャルが上昇し、キャリアに対して障壁となるため、キャリアの電流輸送特性を低下することが知られている。チャネル形成領域の半導体膜の結晶性は、TFTの特性に重大な影響を及ぼすが、結晶粒界の影響を排除して単結晶の半導体膜で前記チャネル形成領域を形成することはほとんど不可能であった。

【0006】このような問題を解決するために、レーザアニール法において、位置制御され、しかも大粒径の結晶粒を形成する様々な試みがなされている。ここではまず、半導体膜にレーザ光を照射した後の前記半導体膜の固化過程について説明する。

【0007】レーザ光の照射によって完全溶融した液体半導体膜中に固相核生成が発生するまでにはある程度の時間が掛かり、完全溶融領域において無数の均一（あるいは不均一）核生成が発生し、成長することで、前記液体半導体膜の固化過程は終了する。この場合に得られる結晶粒の位置と大きさはランダムなものとなる。

【0008】また、レーザ光の照射によって前記半導体膜が完全溶融することなく、固相半導体領域が部分的に残存している場合には、レーザ光の照射後、直ちに前記固相半導体領域から結晶成長が始まる。既に述べたように、完全溶融領域において核生成が発生するにはある程度時間が掛かる。そのため、完全溶融領域において核生成が発生するまでの間に、前記半導体膜の膜面に対する水平方向（以下、ラテラル方向と呼ぶ）に結晶成長の先端である固液界面が移動することで、結晶粒は膜厚の数十倍もの長さに成長する。このような成長は、完全溶融領域において無数の均一（あるいは不均一）核生成が発生することで終了する。以下、この現象をスーパーラテラル成長と言う。

【0009】非晶質半導体膜や多結晶半導体膜においても、前記スーパーラテラル成長が実現するレーザ光のエネルギー領域は存在する。しかしながら、前記エネルギー領域は非常に狭く、また、大結晶粒の得られる位置については制御が困難であった。さらに、大結晶粒以外の領域は無数の核生成が発生した微結晶領域、もしくは非晶質領域であった。

【0010】以上に説明したように、半導体膜が完全溶融するレーザ光のエネルギー領域でラテラル方向の温度勾配を制御する（ラテラル方向への熱流を生じさせる）ことが出来れば、結晶粒の成長位置および成長方向を制御することが出来る。この方法を実現するために様々な試みがなされている。

【0011】例えば、「R. Ishihara and A. Burtsev: AM-LCD '98., p153-p156, 1998」では、基板と下地の酸化シリコン膜との間に高融点金属膜を形成し、前記高融点金属膜の上方に非晶質珪素膜を形成し、エキシマレーザのレーザ光を基板の表面（本明細書中では膜が形成されている面と定義する）と裏面（本明細書中では膜が形成されている面と反対側の面と定義する）の両側から照射するレーザアニール法についての報告がある。基板の表面から照射されるレーザ光は、珪素膜に吸収されて熱に変わる。一方、基板の裏側から照射されるレーザ光は前記高融点金属膜に吸収されて熱に変わり、前記高融点金属膜を高温で加熱する。加熱された前記高融点金属膜と珪素膜の間の前記酸化シリコン膜が、熱の蓄積層として働くため、溶融している珪素膜の冷却速度を遅くする事ができる。ここでは、高融点金属膜を任意の場所に形成することにより、任意の場所に最大で直径6.4μmの結晶粒を得ることが出来る事が報告されている。

【0012】また、コロンビア大のJames S. Im氏ら

は、任意の場所にスーパーラテラル成長を実現させることの出来るSequential Lateral Solidification method (以下、SLS法と言う。) を示した。SLS法は、1ショット毎にスリット状のマスクをスーパーラテラル成長が行なわれる距離程度（約0.75μm）ずらして、結晶化を行うものである。

【0013】一方、用いる基板の大面積化はますます進んでいる。1枚の大面積基板を用いて、複数の液晶表示装置用パネルなどの半導体装置を作製する方がスループットが高く、コストの低減が実現できるためである。大面積基板として、例えば600mm×720mmの基板や320mm×400mmの基板、円形の12インチ（直径約300mm）の基板等使用されるようになっている。さらに、将来的には一辺が1mを越える基板も用いられるものと考えられる。

【0014】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、大面積基板においても、単結晶に近い結晶性を有する結晶質半導体膜を効率よく形成するためのレーザ照射方法およびその装置を提供することを課題とする。また、前記レーザ照射方法を工程に含む半導体装置の作製方法を提供することを課題とする。

【0015】

【課題を解決するための手段】本明細書で開示するレーザ照射装置に関する発明の構成は、レーザと、照射面におけるレーザ光の照射位置を第1の方向または第1の方向とは逆方向へ移動させる手段1と、前記照射面における前記レーザ光の形状を橢円状または矩形状にする手段2と、少なくとも第2の方向に動くステージとを有することを特徴としている。

【0016】また、レーザ照射装置に関する発明の他の構成は、レーザと、照射面におけるレーザ光の照射位置を第1の方向または第1の方向とは逆方向へ移動させる手段1と、前記照射面における前記レーザ光の形状を橢円状または矩形状にする手段2と、少なくとも第2の方向に動き、かつ、前記レーザ光に対して斜めに設置されたステージと、を有することを特徴としている。

【0017】上記発明の各構成において、前記レーザは、連続発振またはパルス発振のエキシマレーザ、Arレーザ、Krレーザから選ばれた一種または複数種であることを特徴としている。

【0018】また、上記発明の各構成において、前記レーザは、連続発振またはパルス発振の固体レーザであることを特徴としている。前記固体レーザは、連続発振またはパルス発振のYAGレーザ、YVO₄レーザ、YLFレーザ、YA1O₃レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ti:サファイアレーザから選ばれた一種または複数種であることを特徴としている。

【0019】また、上記発明の各構成において、前記手

50

段1は、ガルバノメータまたはポリゴンミラーを有することを特徴としている。

【0020】また、上記発明の各構成において、前記手段1は、ガルバノメータまたはポリゴンミラーおよびf-θレンズを有することを特徴としている。

【0021】また、上記発明の各構成において、前記手段2は、シリンドリカルレンズを有することを特徴としている。

【0022】また、本明細書で開示するレーザ照射方法に関する発明の構成は、レーザからレーザ光を発振し、シリンドリカルレンズにより照射面における前記レーザ光の形状を橢円状または矩形状にし、ガルバノメータまたはポリゴンミラーにより前記レーザ光の照射位置を移動させながら前記照射面に照射することを特徴としている。

【0023】また、レーザ照射方法に関する発明の他の構成は、レーザからレーザ光を発振し、シリンドリカルレンズにより照射面におけるレーザ光の形状を橢円状または矩形状にし、ガルバノメータまたはポリゴンミラーにより前記レーザ光の照射位置を移動させ、かつ、前記レーザ光を前記照射面に対して斜めに照射することを特徴としている。

【0024】上記発明の各構成において、前記レーザとして、連続発振またはパルス発振のエキシマレーザ、Arレーザ、Krレーザから選ばれた一種または複数種を用いることを特徴としている。

【0025】また、上記発明の各構成において、前記レーザとして、連続発振またはパルス発振の固体レーザを用いることを特徴としている。

【0026】また、上記発明の各構成において、前記レーザとして、連続発振またはパルス発振のYAGレーザ、YVO₄レーザ、YLFレーザ、YA1O₃レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ti:サファイアレーザから選ばれた一種または複数種を用いることを特徴としている。

【0027】また、本明細書で開示する半導体装置の作製方法に関する発明の構成は、絶縁表面上に半導体膜を形成し、レーザからレーザ光を発振し、シリンドリカルレンズにより前記半導体膜における前記レーザ光の形状を橢円状または矩形状にし、ガルバノメータまたはポリゴンミラーにより前記レーザ光の照射位置を移動させながら前記半導体膜に照射することを特徴としている。

【0028】また、半導体装置の作製方法に関する発明の他の構成は、絶縁表面上に半導体膜を形成し、レーザからレーザ光を発振し、シリンドリカルレンズにより前記半導体膜における前記レーザ光の形状を橢円状または矩形状にし、ガルバノメータまたはポリゴンミラーにより前記レーザ光の照射位置を移動させ、かつ、前記レーザ光を前記照射面に対して斜めに照射することを特徴としている。

【0029】上記発明の各構成において、前記レーザとして、連続発振またはパルス発振のエキシマレーザ、Arレーザ、Krレーザから選ばれた一種または複数種を用いることを特徴としている。

【0030】また、上記発明の各構成において、前記レーザとして、連続発振またはパルス発振の固体レーザを用いることを特徴としている。

【0031】また、上記発明の各構成において、前記レーザとして、連続発振またはパルス発振のYAGレーザ、YVO₄レーザ、YLFLレーザ、YAlO₃レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、アレキサンドライドレーザ、Ti:サファイアレーザから選ばれた一種または複数種を用いることを特徴としている。

【0032】

【発明の実施の形態】レーザから射出されたレーザ光の形状は、レーザの種類によって異なる。例えば、ラムダ社製のXeClエキシマレーザ（波長308nm、パルス幅30ns）L3308レーザ光のサイズは、10mm×30mm（共にビームプロファイルにおける半値幅）である。また、YAGレーザは、ロッド形状が円筒形であればレーザ光の形状は円状となり、スラブ型であればレーザ光の形状は矩形状となる。

【0033】これらのようなレーザ光にガルバノメータやポリゴンミラーなどを利用して、基板全面に対してレーザアニールを行う。このとき、前記照射面におけるレーザ光の形状は光学系により短軸の長さが3～100μmとし、長軸の長さが100μm以上である矩形状または橢円形状であるとする。前記形状を矩形状または橢円状としたのは、基板全面を効率よくレーザアニールするためである。ここで、長軸の長さを100μm以上としたのは、レーザアニールに適したエネルギー密度を有するレーザ光であれば、実施者が長軸の長さを適宜決定すればよいからである。

【0034】ここで、照射方法について図1および図2を用いて説明する。

【0035】レーザ光11を照射領域の一方の端から12で示す方向へ照射し、他方の端までの照射が終わると、該レーザ光の長軸の長さ分、該レーザ光に対して相対的に13で示す方向へ基板を移動させ、12で示す方向とは逆方向への照射を行う。このような動作を繰り返すと、照射領域全面に対してレーザアニールを行うことができる。（図1(A)）もちろん、同一領域を複数回照射した後、レーザ光の長軸の長さ分、該レーザ光に対して相対的に13で示す方向へ基板を移動させて、再度照射することも可能である。また、図1(B)で示すように、レーザ光を照射領域の一方の端から14で示す方向へ照射しつつ、該レーザ光に対して相対的に15で示す方向へ基板を移動させることもできる。

【0036】また、図2(A)で示すように、レーザ光11を照射領域の一方の端から16で示す方向へ照射

10

20

30

40

50

し、他方の端までの照射が終わると、該レーザ光の長軸の長さ分、該レーザ光に対して相対的に17で示す方向へ基板を移動させ、16で示す方向への照射を行うこともできる。このような動作を繰り返すと、照射領域全面に対してレーザアニールを行うことができる。もちろん、同一領域を複数回照射した後、レーザ光の長軸の長さ分、該レーザ光に対して相対的に17で示す方向へ基板を移動させて、再度照射することも可能である。また、図2(B)で示すように、レーザ光を照射領域の一方の端から18で示す方向へ照射しつつ、該レーザ光に対して相対的に19で示す方向へ基板を移動させることもできる。

【0037】ここで、このような照射方法を用いて、半導体膜の結晶化を行う場合について説明する。レーザ光が半導体膜に照射されると、照射された領域は溶融状態になり、時間がたつにつれ冷却し固化する。レーザ光を移動させながら照射すれば、次々と溶融状態である領域が形成される一方で、時間の経過により冷却し固化する領域も存在する。つまり、半導体膜において温度勾配が形成され、レーザ光の移動方向に沿って結晶粒が成長し、大粒径の結晶粒が形成される。このような結晶粒をチャネル形成領域に用いて作製されたTFTの電気的特性は向上し、さらには半導体装置の動作特性および信頼性をも向上し得る。特にレーザ光の移動方向には結晶粒界がほとんどないため、この方向に平行なチャネル形成領域を有するTFTを作製することが好ましい。

【0038】このような照射方法を用いれば、大面積基板に対しても、効率よく、レーザアニールを行うことができる。また、このようなレーザアニールにより半導体膜の結晶化を行うと、位置制御された大粒径の結晶粒を有する半導体膜を形成することが可能となる。さらに前記半導体膜を用いて作製されたTFTの電気的特性は向上し、半導体装置の動作特性および信頼性をも向上し得る。

【0039】

【実施例】【実施例1】本実施例では、ガルバノメータを用い、基板全面にレーザ光を照射するための装置および方法について説明する。

【0040】レーザ101から出たレーザ光がビームコリメータ102によって平行光線に変換され、前記レーザ光は更にガルバノメータ103、f-θレンズ104、シリンドリカルレンズ105を経て基板106に達している。ガルバノメータ103が振動することにより、ガルバノメータのミラーの角度が時間変化し、基板上でのレーザ光の位置が108で示した矢印の方向へ移動する。ガルバノメータが半周期振動すると、基板の幅の端から端までレーザ光が移動するように調整されている。このとき、基板上でのレーザ光の位置が移動しても、レーザ光のエネルギー密度が基板上で常に一定になるようにf-θレンズ104は調整されている。また、照射面に

おけるレーザ光の形状を一方向に拡大するためにシリンドリカルレンズ105を設置している。

【0041】ガルバノメータが半周期振動すると、基板の幅の端から端までレーザ光が移動する。これにより、レーザ光の照射された部分がレーザアニールされる。レーザ光の照射領域が断続的にならないように、ガルバノメータの振動の速度を調整する。その後、ステージが109で示した矢印の方向に移動して、再び基板上で108で示した方向へのレーザ光の移動が始まる。これらの動作を繰り返すことにより、基板全面をレーザアニールすることができる。このときの基板におけるレーザ光の照射の様子は図1(A)で示す。すなわち、ガルバノメータの回転による照射位置の移動とステージの移動とを繰り返すことで基板全面にレーザが照射される。

【0042】また、ステージを109で示した矢印の方向に移動させながら、108で示した方向へレーザ光の照射を行うと、基板におけるレーザ光の照射の様子は図1(B)となる。図1(B)においても、ガルバノメータの回転による照射位置の移動とステージの移動とにより基板全面にレーザが照射される。レーザ光の照射位置の移動方向が基板の辺に対して斜めとなるのは、ステージとレーザ光の移動方向が合成されるからである。ガルバノメータにより移動するレーザ光の照射位置は往復運動をするため、効率よくレーザ光を基板に照射するためには、図1に記載の照射方法により行うことが好ましい。しかしながら、プロセスの都合でレーザ光の移動方向を一定としたいのであれば、ガルバノメータを半周期振動させた後、レーザ光を遮断し、これを繰り返せばよい。

【0043】【実施例2】本実施例では、ポリゴンミラーを用い、基板全面にレーザ光を照射するための装置および方法について説明する。

【0044】レーザ101から出たレーザ光がビームコリメータ102によって平行光線に変換され、前記レーザ光は更にポリゴンミラー113、f-θレンズ114、シリンドリカルレンズ115を経て基板106に達している。ポリゴンミラー113は複数のミラーからなり、ポリゴンミラー113が回転することにより、ミラーの角度が時間変化し、基板上でのレーザ光の位置が118で示した矢印の方向へ移動する。ポリゴンミラーが回転する間、レーザ光は所定の位置で振動するが、基板の幅の端から端までレーザ光が移動するように調整されている。このとき、基板上でのレーザ光の位置が移動しても、レーザ光のエネルギー密度が基板上で常に一定になるようにf-θレンズ114は調整されている。また、照射面におけるレーザ光の形状を一方向に拡大するためにシリンドリカルレンズ115を設置している。

【0045】ポリゴンミラー113が回転すると、ポリゴンミラー113を構成するうちの1つのミラーにレーザ光が照射される間に、基板の幅の端から端までレーザ

光が移動する。これにより、レーザ光の照射された部分がレーザアニールされる。レーザ光によるレーザアニールが適当に行なわれるよう、ポリゴンミラーの回転の速度を調整する。その後、ステージが119で示した矢印の方向に移動して、再び基板上で118で示した方向へのレーザ光の移動が始まる。前記移動の距離は、レーザ光の大きさに依存し、レーザアニールが基板全体に一様に成されるように調整する。これらの動作を繰り返すことにより、基板全面をレーザアニールすることができる。このときの基板におけるレーザ光の照射の様子を図2(A)で示す。すなわち、ポリゴンミラーの回転による照射位置の移動とステージの移動とを繰り返すことで基板全面にレーザが照射される。

【0046】また、ステージを119で示した矢印の方向に移動させながら、118で示した方向へレーザ光の照射を行うと、基板におけるレーザ光の照射の様子は図2(B)となる。図2(B)においても、ポリゴンミラーの回転による照射位置の移動とステージの移動とにより基板全面にレーザが照射される。

【0047】さらに、図4で示すように、基板117をf-θレンズ115やシリンドリカルレンズ116に対して斜めに設置すれば、戻り光、すなわち基板表面からの反射光がレーザ装置に達することが無くなるため、特にレーザ発振機に固体レーザを使う場合には有効である。

【0048】また、基板117をf-θレンズ115やシリンドリカルレンズ116に対して、シリンドリカルレンズ115の母線を軸に回転させ斜めに設置すれば、照射面におけるレーザ光の形状が軸対称性を失わないため、均一なレーザアニールが可能となる。さらに、半導体膜や基板を透過する波長のレーザ光を用いても、基板に入射するレーザ光と基板裏面からの反射光との干渉の影響を低減することができるので、より一様なレーザアニールを行うことができる。

【0049】【実施例3】本実施例では、大面積基板にレーザアニールを行う場合について説明する。

【0050】図5(A)に示すように、アクティブマトリクス型の液晶表示装置などは1枚のガラス基板上に、画素部用と駆動回路用(ソースドライバー部およびゲートドライバー部)のTFTを作製するが、スループットの向上およびコストの低減のため、大面積基板を用いて該大面積基板から複数の液晶表示装置用パネルを作製することが多い。また、画素部と駆動回路部、特に駆動回路部におけるソースドライバー部とゲートドライバー部とでは、チャネル形成領域の方向(キャリアの流れる方向)が一致していない場合が多い。レーザアニールにより一方向に向きの揃った結晶粒を形成し、例えばソースドライバー部において結晶粒界の少ないチャネル形成領域を形成しても、ゲートドライバー部におけるチャネル形成領域は、結晶粒界の多くなり、半導体装置の動作特

性および信頼性を損なう要因となる場合がある。

【0051】そこで、本実施例では、それぞれのドライバー部において、キャリアの流れる方向を妨げることない大粒径の結晶粒を形成する方法について説明する。つまり、ソースドライバー部においては、20の方向に大粒径の結晶粒を形成し同じ方向にチャネル形成領域を形成することでキャリアの流れを良好なものとし、ゲートドライバー部においては、21の方向に大粒径の結晶粒を形成し同じ方向にチャネル形成領域を形成することでキャリアの流れを良好なものとする。

【0052】まず、実施例1または実施例2にしたがって、20の方向にレーザ光を移動させながら照射して、ソースドライバー部となる領域のレーザアニールを行う。続いて、基板を90°回転させ、実施例1または実施例2にしたがって、21の方向にレーザ光を移動させながら照射して、ゲートドライバー部となる領域のレーザアニールを行う。(図5(B))なお、基板の回転は、レーザ光に対して相対的に移動させるものであり、ステージまたは、光学系を回転させればよい。

【0053】本実施例にしたがえば、所望の領域において、キャリアの流れを妨げる結晶粒界の少ないチャネル形成領域を形成することが可能となる。もちろん、基板の回転角度は90度に限らず、所望の角度とすればよい。

【0054】また、複数のレーザ光(または複数のレーザ)を用いて、基板上で多方向に移動させることで、さまざまな向きに作製されるTFTに対応できる。図16に例を示す。レーザ101から発振されたレーザ光が基板106上に照射され、118aで示す方向に移動し、図示しないが他のレーザから発振されたレーザ光がポリゴンミラーおよびf-θレンズを経て120で示す方向へ進み、シリンドリカルレンズ115bにより矩形状又は楕円状となり、基板106上に照射され、118bで示す方向に移動する。このように複数のレーザを用いれば、一度に複数の方向への照射が可能となる。

【0055】【実施例4】本実施例ではアクティブマトリクス基板の作製方法について図6～図9を用いて説明する。本明細書ではCMOS回路、及び駆動回路と、画素TFT、保持容量とを有する画素部を同一基板上に形成された基板を、便宜上アクティブマトリクス基板と呼ぶ。

【0056】まず、本実施例ではコーニング社の#7059ガラスや#1737ガラスなどに代表されるバリウムホウケイ酸ガラス、またはアルミニウムホウケイ酸ガラスなどのガラスからなる基板400を用いる。なお、基板400としては、石英基板やシリコン基板、金属基板またはステンレス基板の表面に絶縁膜を形成したものを用いても良い。また、本実施例の処理温度に耐えうる耐熱性が有するプラスチック基板を用いてもよい。

【0057】次いで、基板400上に酸化珪素膜、窒化

珪素膜または酸化窒化珪素膜などの絶縁膜から成る下地膜401を形成する。本実施例では下地膜401として2層構造を用いるが、前記絶縁膜の単層膜または2層以上積層させた構造を用いても良い。下地膜401の一層目としては、プラズマCVD法を用い、SiH₄、N₂H₄、及びN₂Oを反応ガスとして成膜される酸化窒化珪素膜401aを10～200nm(好ましくは50～100nm)形成する。本実施例では、膜厚50nmの酸化窒化珪素膜401a(組成比Si=32%、O=27%、N=24%、H=17%)を形成した。次いで、下地膜401の二層目としては、プラズマCVD法を用い、SiH₄、及びN₂Oを反応ガスとして成膜される酸化窒化珪素膜401bを50～200nm(好ましくは100～150nm)の厚さに積層形成する。本実施例では、膜厚100nmの酸化窒化珪素膜401b(組成比Si=32%、O=59%、N=7%、H=2%)を形成する。

【0058】次いで、下地膜上に半導体層402～406を形成する。半導体層402～406は公知の手段(スパッタ法、LPCVD法、またはプラズマCVD法等)により25～80nm(好ましくは30～60nm)の厚さで半導体膜を成膜し、レーザ結晶化法により結晶化させる。もちろん、レーザ結晶化法だけでなく、他の公知の結晶化法(RTAやファーネスアニール炉を用いた熱結晶化法、結晶化を助長する金属元素を用いた熱結晶化法等)と組み合わせて行ってもよい。そして、得られた結晶質半導体膜を所望の形状にパターニングして半導体層402～406を形成する。前記半導体膜としては、非晶質半導体膜や微結晶半導体膜、結晶質半導体膜などがあり、非晶質珪素ゲルマニウム膜などの非晶質構造を有する化合物半導体膜を適用しても良い。

【0059】レーザ結晶化法で結晶質半導体膜を作製するには、パルス発振型または連続発光型のエキシマレーザやYAGレーザ、YVO₄レーザ、YLFレーザ、YA1O₃レーザ、ガラスレーザ、ルビーレーザ、Ti:Sファイアレーザ等を用いることができる。これらのレーザを用いる場合には、レーザから放射されたレーザビームを光学系で矩形状または楕円状に集光し半導体膜に照射する方法を用いると良い。結晶化の条件は実施者が適宜選択する。

【0060】本実施例では、プラズマCVD法を用い、55nmの非晶質珪素膜を成膜する。そして、連続発光のYVO₄レーザの第2高調波を用い、図2または図3に示すような光学系により結晶化を行って結晶質珪素膜を形成する。そして、フォトリソグラフィ法を用いたパターニング処理によって半導体層402～406を形成する。

【0061】また、半導体層402～406を形成した後、TFTのしきい値を制御するために微量な不純物元素(ボロンまたはリン)のドーピングを行ってもよい。

【0062】次いで、半導体層402～406を覆うゲート絶縁膜407を形成する。ゲート絶縁膜407はプラズマCVD法またはスパッタ法を用い、厚さを40～150nmとして珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマCVD法により110nmの厚さで酸化窒化珪素膜（組成比Si=32%、O=59%、N=7%、H=2%）で形成した。勿論、ゲート絶縁膜は酸化窒化珪素膜に限定されるものではなく、他の珪素を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【0063】また、酸化珪素膜を用いる場合には、プラズマCVD法でTEOS（Tetraethyl Orthosilicate）とO₂とを混合し、反応圧力40Pa、基板温度300～400°Cとし、高周波（13.56MHz）電力密度0.5～0.8W/cm²で放電させて形成することができる。このようにして作製される酸化珪素膜は、その後400～500°Cの熱アニールによりゲート絶縁膜として良好な特性を得ることができる。

【0064】次いで、ゲート絶縁膜407上に膜厚20～100nmの第1の導電膜408と、膜厚100～400nmの第2の導電膜409とを積層形成する。本実施例では、膜厚30nmのTaN膜からなる第1の導電膜408と、膜厚370nmのW膜からなる第2の導電膜409を積層形成した。TaN膜はスパッタ法で形成し、Taのターゲットを用い、窒素を含む雰囲気内でスパッタした。また、W膜は、Wのターゲットを用いたスパッタ法で形成した。その他に6フッ化タンゲステン（WF₆）を用いる熱CVD法で形成することもできる。いずれにしてもゲート電極として使用するためには低抵抗化を図る必要があり、W膜の抵抗率は20μΩcm以下にすることが望ましい。W膜は結晶粒を大きくすることで低抵抗率化を図ることができると、W膜中に酸素などの不純物元素が多い場合には結晶化が阻害され高抵抗化する。従って、本実施例では、高純度のW（純度99.9999%）のターゲットを用いたスパッタ法で、さらに成膜時に気相中からの不純物の混入がないよう十分配慮してW膜を形成することにより、抵抗率9～20μΩcmを実現することができた。

【0065】なお、本実施例では、第1の導電膜408をTaN、第2の導電膜409をWとしたが、特に限定されず、いずれもTa、W、Ti、Mo、Al、Cu、Cr、Ndから選ばれた元素、または前記元素を主成分とする合金材料若しくは化合物材料で形成してもよい。また、リン等の不純物元素をドーピングした多結晶珪素膜に代表される半導体膜を用いてもよい。また、AgPdCu合金を用いてもよい。また、第1の導電膜をタンタル（Ta）膜で形成し、第2の導電膜をW膜とする組み合わせ、第1の導電膜を窒化チタン（TiN）膜で形成し、第2の導電膜をW膜とする組み合わせ、第1の導電膜を窒化タンタル（TaN）膜で形成し、第2の導電膜をA1膜とする組み合わせ、第1の導電膜を窒化タン

タル（TaN）膜で形成し、第2の導電膜をCu膜とする組み合わせとしてもよい。

【0066】次に、フォトリソグラフィ法を用いてレジストからなるマスク410～415を形成し、電極及び配線を形成するための第1のエッチング処理を行う。第1のエッチング処理では第1及び第2のエッチング条件で行う。（図6（B））本実施例では第1のエッチング条件として、ICP（Inductively Coupled Plasma：誘導結合型プラズマ）エッチング法を用い、エッチング用ガスにCF₄とCl₂とO₂とを用い、それぞれのガス流量比を25/25/10（sccm）とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF（13.56MHz）電力を投入してプラズマを生成してエッチングを行った。ここでは、松下電器産業（株）製のICPを用いたドライエッチング装置（Model E645-□ICP）を用いた。基板側（試料ステージ）にも150WのRF（13.56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。この第1のエッチング条件によりW膜をエッチングして第1の導電層の端部をテーパー形状とする。

【0067】この後、レジストからなるマスク410～415を除去せずに第2のエッチング条件に変え、エッチング用ガスにCF₄とCl₂とを用い、それぞれのガス流量比を30/30（sccm）とし、1Paの圧力でコイル型の電極に500WのRF（13.56MHz）電力を投入してプラズマを生成して約30秒程度のエッチングを行った。基板側（試料ステージ）にも20WのRF（13.56MHz）電力を投入し、実質的に負の自己バイアス電圧を印加する。CF₄とCl₂を混合した第2のエッチング条件ではW膜及びTaN膜とも同程度にエッチングされる。なお、ゲート絶縁膜上に残渣を残すことなくエッチングするためには、10～20%程度の割合でエッチング時間を増加させると良い。

【0068】上記第1のエッチング処理では、レジストからなるマスクの形状を適したものとすることにより、基板側に印加するバイアス電圧の効果により第1の導電層及び第2の導電層の端部がテーパー形状となる。このテーパー部の角度は15～45°となる。こうして、第1のエッチング処理により第1の導電層と第2の導電層から成る第1の形状の導電層417～422（第1の導電層417a～422aと第2の導電層417b～422b）を形成する。416はゲート絶縁膜であり、第1の形状の導電層417～422で覆われない領域は20～50nm程度エッチングされ薄くなった領域が形成される。

【0069】次いで、レジストからなるマスクを除去せずに第2のエッチング処理を行う。（図6（C））ここでは、エッチングガスにCF₄とCl₂とO₂とを用い、W膜を選択的にエッチングする。この時、第2のエッチング処理により第2の導電層428b～433bを形成する。一方、第1の導電層417a～422aは、ほと

んどエッチングされず、第2の形状の導電層428～433を形成する。

【0070】そして、レジストからなるマスクを除去せずに第1のドーピング処理を行い、半導体層にn型を付与する不純物元素を低濃度に添加する。ドーピング処理はイオンドープ法、若しくはイオン注入法で行えば良い。イオンドープ法の条件はドーズ量を $1 \times 10^{13} \sim 5 \times 10^{14}/\text{cm}^2$ とし、加速電圧を40～80 keVとして行う。本実施例ではドーズ量を $1.5 \times 10^{13}/\text{cm}^2$ とし、加速電圧を60 keVとして行う。n型を付与する不純物元素として15族に属する元素、典型的にはリン(P)または砒素(As)を用いるが、ここではリン(P)を用いる。この場合、導電層428～433がn型を付与する不純物元素に対するマスクとなり、自己整合的に不純物領域423～427が形成される。不純物領域423～427には $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{14}/\text{cm}^3$ の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加する。

【0071】レジストからなるマスクを除去した後、新たにレジストからなるマスク434a～434cを形成して第1のドーピング処理よりも高い加速電圧で第2のドーピング処理を行う。イオンドープ法の条件はドーズ量を $1 \times 10^{13} \sim 1 \times 10^{15}/\text{cm}^2$ とし、加速電圧を60～120 keVとして行う。ドーピング処理は第2の導電層428b～432bを不純物元素に対するマスクとして用い、第1の導電層のテーパー部の下方の半導体層に不純物元素が添加されるようにドーピングする。続いて、第2のドーピング処理より加速電圧を下げて第3のドーピング処理を行って図7(A)の状態を得る。イオンドープ法の条件はドーズ量を $1 \times 10^{15} \sim 1 \times 10^{17}/\text{cm}^2$ とし、加速電圧を50～100 keVとして行う。第2のドーピング処理および第3のドーピング処理により、第1の導電層と重なる低濃度不純物領域436、442、448には $1 \times 10^{13} \sim 5 \times 10^{14}/\text{cm}^3$ の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加され、高濃度不純物領域435、438、441、444、447には $1 \times 10^{19} \sim 5 \times 10^{21}/\text{cm}^3$ の濃度範囲でn型を付与する不純物元素を添加される。

【0072】もちろん、適当な加速電圧にすることで、第2のドーピング処理および第3のドーピング処理は1回のドーピング処理で、低濃度不純物領域および高濃度不純物領域を形成することも可能である。

【0073】次いで、レジストからなるマスクを除去した後、新たにレジストからなるマスク450a～450cを形成して第4のドーピング処理を行う。この第4のドーピング処理により、pチャネル型TFTの活性層となる半導体層に前記一導電型とは逆の導電型を付与する不純物元素が添加された不純物領域453～456、459、460を形成する。第2の導電層428a～432aを不純物元素に対するマスクとして用い、p型を付与する不純物元素を添加して自己整合的に不純物領域を

形成する。本実施例では、不純物領域453～456、459、460はジボラン(B_2H_6)を用いたイオンドープ法で形成する。(図7(B))この第4のドーピング処理の際には、nチャネル型TFTを形成する半導体層はレジストからなるマスク450a～450cで覆われている。第1乃至3のドーピング処理によって、不純物領域438、439にはそれぞれ異なる濃度でリンが添加されているが、そのいずれの領域においてもp型を付与する不純物元素の濃度を $1 \times 10^{19} \sim 5 \times 10^{21}/\text{cm}^3$ となるようにドーピング処理することにより、pチャネル型TFTのソース領域およびドレイン領域として機能するために何ら問題は生じない。

【0074】以上までの工程で、それぞれの半導体層に不純物領域が形成される。

【0075】次いで、レジストからなるマスク450a～450cを除去して第1の層間絶縁膜461を形成する。この第1の層間絶縁膜461としては、プラズマCVD法またはスパッタ法を用い、厚さを100～200 nmとして珪素を含む絶縁膜で形成する。本実施例では、プラズマCVD法により膜厚150 nmの酸化窒化珪素膜を形成した。勿論、第1の層間絶縁膜461は酸化窒化珪素膜に限定されるものではなく、他の珪素を含む絶縁膜を単層または積層構造として用いても良い。

【0076】次いで、図7(C)に示すように、加熱処理を行って、半導体層の結晶性の回復、それぞれの半導体層に添加された不純物元素の活性化を行う。この加熱処理はファーネスアニール炉を用いる熱アニール法で行う。熱アニール法としては、酸素濃度が1 ppm以下、好ましくは0.1 ppm以下の窒素雰囲気中で400～700℃、代表的には500～550℃で行えばよく、本実施例では550℃、4時間の熱処理で活性化処理を行った。なお、熱アニール法の他に、レーザアニール法、またはラピッドサーマルアニール法(RTA法)を適用することができる。

【0077】また、第1の層間絶縁膜を形成する前に加熱処理を行っても良い。ただし、用いた配線材料が熱に弱い場合には、本実施例のように配線等を保護するため層間絶縁膜(珪素を主成分とする絶縁膜、例えば窒化珪素膜)を形成した後で活性化処理を行うことが好ましい。

【0078】そして、加熱処理(300～550℃で1～2時間の熱処理)を行うと水素化を行うことができる。この工程は第1の層間絶縁膜461に含まれる水素により半導体層のダングリングボンドを終端する工程である。第1の層間絶縁膜の存在に関係なく半導体層を水素化することができる。水素化の他の手段として、プラズマ水素化(プラズマにより励起された水素を用いる)や、3～100%の水素を含む雰囲気中で300～450℃で1～2時間の加熱処理を行っても良い。

【0079】また、活性化処理としてレーザアニール法

を用いる場合には、上記水素化を行った後、エキシマレーザやYAGレーザ等のレーザビームを照射することが望ましい。

【0080】次いで、第1の層間絶縁膜461上に無機絶縁膜材料または有機絶縁物材料から成る第2の層間絶縁膜462を形成する。本実施例では、膜厚1.6μmのアクリル樹脂膜を形成したが、粘度が10～1000cP、好ましくは40～200cPのものを用い、表面に凸凹が形成されるものを用いる。

【0081】本実施例では、鏡面反射を防ぐため、表面に凸凹が形成される第2の層間絶縁膜を形成することによって画素電極の表面に凸凹を形成した。また、画素電極の表面に凹凸を持たせて光散乱性を図るために、画素電極の下方の領域に凸部を形成してもよい。その場合、凸部の形成は、TFTの形成と同じフォトマスクで行うことができるため、工程数の増加なく形成することができる。なお、この凸部は配線及びTFT部以外の画素部領域の基板上に適宜設ければよい。こうして、凸部を覆う絶縁膜の表面に形成された凸凹に沿って画素電極の表面に凸凹が形成される。

【0082】また、第2の層間絶縁膜462として表面が平坦化する膜を用いてもよい。その場合は、画素電極を形成した後、公知のサンドブラスト法やエッチング法等の工程を追加して表面を凹凸化させて、鏡面反射を防ぎ、反射光を散乱させることによって白色度を増加させることができが望ましい。

【0083】そして、駆動回路506において、各不純物領域とそれぞれ電気的に接続する配線464～468を形成する。なお、これらの配線は、膜厚50nmのTi膜と、膜厚500nmの合金膜(A1とTiとの合金膜)との積層膜をバーニングして形成する。もちろん、二層構造に限らず、単層構造でもよいし、三層以上の積層構造にしてもよい。また、配線の材料としては、A1とTiに限らない。例えば、TaN膜上にA1やCuを形成し、さらにTi膜を形成した積層膜をバーニングして配線を形成してもよい。(図8)

【0084】また、画素部507においては、画素電極470、ゲート配線469、接続電極468を形成する。この接続電極468によりソース配線(443aと443bの積層)は、画素TFTと電気的な接続が形成される。また、ゲート配線469は、画素TFTのゲート電極と電気的な接続が形成される。また、画素電極470は、画素TFTのドレイン領域442と電気的な接続が形成され、さらに保持容量を形成する一方の電極として機能する半導体層458と電気的な接続が形成される。また、画素電極471としては、A1またはAgを主成分とする膜、またはそれらの積層膜等の反射性の優れた材料を用いることが望ましい。

【0085】以上の様にして、nチャネル型TFT501とpチャネル型TFT502からなるCMOS回路、

及びnチャネル型TFT503を有する駆動回路506と、画素TFT504、保持容量505とを有する画素部507を同一基板上に形成することができる。こうして、アクティブマトリクス基板が完成する。

【0086】駆動回路506のnチャネル型TFT501はチャネル形成領域437、ゲート電極の一部を構成する第1の導電層428aと重なる低濃度不純物領域436(GOLD領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域452と、n型を付与する不純物元素およびp型を付与する不純物元素が導入された不純物領域451を有している。このnチャネル型TFT501と電極466で接続してCMOS回路を形成するpチャネル型TFT502にはチャネル形成領域440、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域454と、n型を付与する不純物元素およびp型を付与する不純物元素が導入された不純物領域453を有している。また、nチャネル型TFT503にはチャネル形成領域443、ゲート電極の一部を構成する第1の導電層430aと重なる低濃度不純物領域442(GOLD領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域456と、n型を付与する不純物元素およびp型を付与する不純物元素が導入された不純物領域455を有している。

【0087】画素部の画素TFT504にはチャネル形成領域446、ゲート電極の外側に形成される低濃度不純物領域445(LDD領域)、ソース領域またはドレイン領域として機能する高濃度不純物領域458と、n型を付与する不純物元素およびp型を付与する不純物元素が導入された不純物領域457を有している。また、保持容量505の一方の電極として機能する半導体層には、n型を付与する不純物元素およびp型を付与する不純物元素が添加されている。保持容量505は、絶縁膜416を誘電体として、電極(432aと432bの積層)と、半導体層とで形成している。

【0088】本実施例の画素構造は、ブラックマトリクスを用いることなく、画素電極間の隙間が遮光されるように、画素電極の端部をソース配線と重なるように配置形成する。

【0089】また、本実施例で作製するアクティブマトリクス基板の画素部の上面図を図9に示す。なお、図6～図9に対応する部分には同じ符号を用いている。図8中の鎖線A-A'は図9中の鎖線A-A'で切断した断面図に対応している。また、図8中の鎖線B-B'は図9中の鎖線B-B'で切断した断面図に対応している。

【0090】なお、本実施例は実施例1乃至3のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【0091】【実施例5】本実施例では、実施例4で作製したアクティブマトリクス基板から、反射型液晶表示装置を作製する工程を以下に説明する。説明には図10を用いる。

【0092】まず、実施例4に従い、図8の状態のアクティブマトリクス基板を得た後、図8のアクティブマトリクス基板上、少なくとも画素電極470上に配向膜567を形成しラビング処理を行う。なお、本実施例では配向膜567を形成する前に、アクリル樹脂膜等の有機樹脂膜をバーニングすることによって基板間隔を保持するための柱状のスペーサ572を所望の位置に形成した。また、柱状のスペーサに代えて、球状のスペーサを基板全面に散布してもよい。

【0093】次いで、対向基板569を用意する。次いで、対向基板569上に着色層570、571、平坦化膜573を形成する。赤色の着色層570と青色の着色層571とを重ねて、遮光部を形成する。また、赤色の着色層と緑色の着色層とを一部重ねて、遮光部を形成してもよい。

【0094】本実施例では、実施例4に示す基板を用いている。従って、実施例4の画素部の上面図を示す図9では、少なくともゲート配線469と画素電極470の間隙と、ゲート配線469と接続電極468の間隙と、接続電極468と画素電極470の間隙を遮光する必要がある。本実施例では、それらの遮光すべき位置に着色層の積層からなる遮光部が重なるように各着色層を配置して、対向基板を貼り合わせた。

【0095】このように、ブラックマスク等の遮光層を形成することなく、各画素間の隙間を着色層の積層からなる遮光部で遮光することによって工程数の低減を可能とした。

【0096】次いで、平坦化膜573上に透明導電膜からなる対向電極576を少なくとも画素部に形成し、対向基板の全面に配向膜574を形成し、ラビング処理を施した。

【0097】そして、画素部と駆動回路が形成されたアクティブマトリクス基板と対向基板とをシール材568で貼り合わせる。シール材568にはフィラーが混入されていて、このフィラーと柱状スペーサによって均一な間隔を持って2枚の基板が貼り合わせられる。その後、両基板の間に液晶材料575を注入し、封止剤(図示せず)によって完全に封止する。液晶材料575には公知の液晶材料を用いれば良い。このようにして図10に示す反射型液晶表示装置が完成する。そして、必要があれば、アクティブマトリクス基板または対向基板を所望の形状に分断する。さらに、対向基板のみに偏光板(図示しない)を貼りつけた。そして、公知の技術を用いてFPCを貼りつけた。

【0098】以上のようにして作製される液晶表示装置は大粒径の結晶粒を有する半導体膜を用いて作製されており、前記液晶表示装置の動作特性や信頼性を十分なものとなり得る。そして、このような液晶表示装置は各種電子機器の表示部として用いることができる。

【0099】なお、本実施例は実施例1乃至4と自由に

10

20

20

30

40

50

組み合わせることが可能である。

【0100】【実施例6】本実施例では、本発明を用いて発光装置を作製した例について説明する。本明細書において、発光装置とは、基板上に形成された発光素子を該基板とカバー材の間に封入した表示用パネルおよび該表示用パネルにICを実装した表示用モジュールを総称したものである。なお、発光素子は、電場を加えることで発生するルミネッセンス(Electro Luminescence)が得られる有機化合物を含む層(発光層)と陽極層と、陰極層とを有する。また、有機化合物におけるルミネッセンスには、一重項励起状態から基底状態に戻る際の発光(蛍光)と三重項励起状態から基底状態に戻る際の発光(リン光)があり、これらのうちどちらか、あるいは両方の発光を含む。

【0101】なお、本明細書中では、発光素子において陽極と陰極の間に形成された全ての層を有機発光層と定義する。有機発光層には具体的に、発光層、正孔注入層、電子注入層、正孔輸送層、電子輸送層等が含まれる。基本的に発光素子は、陽極層、発光層、陰極層が順に積層された構造を有しており、この構造に加えて、陽極層、正孔注入層、発光層、陰極層や、陽極層、正孔注入層、発光層、電子輸送層、陰極層等の順に積層した構造を有していることもある。

【0102】図11は本実施例の発光装置の断面図である。図11において、基板700上に設けられたスイッチングTFT603は図8のnチャネル型TFT503を用いて形成される。したがって、構造の説明はnチャネル型TFT503の説明を参照すれば良い。

【0103】なお、本実施例ではチャネル形成領域が二つ形成されるダブルゲート構造としているが、チャネル形成領域が一つ形成されるシングルゲート構造もしくは三つ形成されるトリプルゲート構造であっても良い。

【0104】基板700上に設けられた駆動回路は図8のCMOS回路を用いて形成される。従って、構造の説明はnチャネル型TFT501とpチャネル型TFT502の説明を参照すれば良い。なお、本実施例ではシングルゲート構造としているが、ダブルゲート構造もしくはトリプルゲート構造であっても良い。

【0105】また、配線701、703はCMOS回路のソース配線、702はドレイン配線として機能する。また、配線704はソース配線708とスイッチングTFTのソース領域とを電気的に接続する配線として機能し、配線705はドレイン配線709とスイッチングTFTのドレイン領域とを電気的に接続する配線として機能する。

【0106】なお、電流制御TFT604は図8のpチャネル型TFT502を用いて形成される。従って、構造の説明はpチャネル型TFT502の説明を参照すれば良い。なお、本実施例ではシングルゲート構造としているが、ダブルゲート構造もしくはトリプルゲート構造

であっても良い。

【0107】また、配線706は電流制御TFTのソース配線（電流供給線に相当する）であり、707は電流制御TFTの画素電極711上に重ねることで画素電極711と電気的に接続する電極である。

【0108】なお、711は、透明導電膜からなる画素電極（発光素子の陽極）である。透明導電膜としては、酸化インジウムと酸化スズとの化合物、酸化インジウムと酸化亜鉛との化合物、酸化亜鉛、酸化スズまたは酸化インジウムを用いることができる。また、前記透明導電膜にガリウムを添加したものを用いても良い。画素電極711は、上記配線を形成する前に平坦な層間絶縁膜710上に形成する。本実施例においては、樹脂からなる平坦化膜710を用いてTFTによる段差を平坦化することは非常に重要である。後に形成される発光層は非常に薄いため、段差が存在することによって発光不良を起こす場合がある。従って、発光層ができるだけ平坦面に形成しうるように画素電極を形成する前に平坦化しておくことが望ましい。

【0109】配線701～707を形成後、図11に示すようにバンク712を形成する。バンク712は100～400nmの珪素を含む絶縁膜もしくは有機樹脂膜をパターニングして形成すれば良い。

【0110】なお、バンク712は絶縁膜であるため、成膜時における素子の静電破壊には注意が必要である。本実施例ではバンク712の材料となる絶縁膜中にカーボン粒子や金属粒子を添加して抵抗率を下げ、静電気の発生を抑制する。この際、抵抗率は $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^{12} \Omega m$ （好ましくは $1 \times 10^8 \sim 1 \times 10^{10} \Omega m$ ）となるようにカーボン粒子や金属粒子の添加量を調節すれば良い。

【0111】画素電極711の上には発光層713が形成される。なお、図11では一画素しか図示していないが、本実施例ではR（赤）、G（緑）、B（青）の各色に対応した発光層を作り分けている。また、本実施例では蒸着法により低分子系有機発光材料を形成している。具体的には、正孔注入層として20nm厚の銅フタロシアニン（CuPc）膜を設け、その上に発光層として70nm厚のトリス-8-キノリノラトアルミニウム錯体（Alq₃）膜を設けた積層構造としている。Alq₃にキナクリドン、ペリレンもしくはDCM1といった蛍光色素を添加することで発光色を制御することができる。

【0112】但し、以上の例は発光層として用いることのできる有機発光材料の一例であって、これに限定する必要はまったくない。発光層、電荷輸送層または電荷注入層を自由に組み合わせて発光層（発光及びそのためのキャリアの移動を行わせるための層）を形成すれば良い。例えば、本実施例では低分子系有機発光材料を発光層として用いる例を示したが、中分子系有機発光材料や高分子系有機発光材料を用いても良い。なお、本明細書

中において、昇華性を有さず、かつ、分子数が20以下または連鎖する分子の長さが10μm以下の有機発光材料を中分子系有機発光材料とする。また、高分子系有機発光材料を用いる例として、正孔注入層として20nmのポリチオフェン（PEDOT）膜をスピンドル塗布法により設け、その上に発光層として100nm程度のパラフェニレンビニレン（PPV）膜を設けた積層構造としても良い。なお、PPVのπ共役系高分子を用いると、赤色から青色まで発光波長を選択できる。また、電荷輸送層や電荷注入層として炭化珪素等の無機材料を用いることも可能である。これらの有機発光材料や無機材料は公知の材料を用いることができる。

【0113】次に、発光層713の上には導電膜からなる陰極714が設けられる。本実施例の場合、導電膜としてアルミニウムとリチウムとの合金膜を用いる。勿論、公知のMgAg膜（マグネシウムと銀との合金膜）を用いても良い。陰極材料としては、周期表の1族もしくは2族に属する元素からなる導電膜もしくはそれらの元素を添加した導電膜を用いれば良い。

【0114】この陰極714まで形成された時点で発光素子715が完成する。なお、ここでいう発光素子715は、画素電極（陽極）711、発光層713及び陰極714で形成されたダイオードを指す。

【0115】発光素子715を完全に覆うようにしてパッシベーション膜716を設けることは有効である。パッシベーション膜716としては、炭素膜、窒化珪素膜もしくは窒化酸化珪素膜を含む絶縁膜からなり、該絶縁膜を単層もしくは組み合わせた積層で用いる。

【0116】この際、カバーレッジの良い膜をパッシベーション膜として用いることが好ましく、炭素膜、特にDLC（ダイヤモンドライカーボン）膜を用いることは有効である。DLC膜は室温から100℃以下の温度範囲で成膜可能であるため、耐熱性の低い発光層713の上方にも容易に成膜することができる。また、DLC膜は酸素に対するブロッキング効果が高く、発光層713の酸化を抑制することができる。そのため、この後に続く封止工程を行う間に発光層713が酸化するといった問題を防止できる。

【0117】さらに、パッシベーション膜716上に封止材717を設け、カバー材718を貼り合わせる。封止材717としては紫外線硬化樹脂を用いれば良く、内部に吸湿効果を有する物質もしくは酸化防止効果を有する物質を設けることは有効である。また、本実施例においてカバー材718はガラス基板や石英基板やプラスチック基板（プラスチックフィルムも含む）の両面に炭素膜（好ましくはダイヤモンドライカーボン膜）を形成したもの用いる。

【0118】こうして図11に示すような構造の発光装置が完成する。なお、バンク712を形成した後、パッシベーション膜716を形成するまでの工程をマルチ

ヤンバー方式（またはインライン方式）の成膜装置を用いて、大気開放せずに連続的に処理することは有効である。また、さらに発展させてカバー材718を貼り合わせる工程までを大気開放せずに連続的に処理することも可能である。

【0119】こうして、基板700上にnチャネル型TFT601、602、スイッチングTFT（nチャネル型TFT）603および電流制御TFT（nチャネル型TFT）604が形成される。

【0120】さらに、図11を用いて説明したように、ゲート電極に絶縁膜を介して重なる不純物領域を設けることによりホットキャリア効果に起因する劣化に強いnチャネル型TFTを形成することができる。そのため、信頼性の高い発光装置を実現できる。

【0121】また、本実施例では画素部と駆動回路の構成のみ示しているが、本実施例の製造工程に従えば、その他にも信号分割回路、D/Aコンバータ、オペアンプ、ア補正回路などの論理回路を同一の絶縁体上に形成可能であり、さらにはメモリやマイクロプロセッサをも形成しうる。

【0122】さらに、発光素子を保護するための封止（または封入）工程まで行った後の本実施例の発光装置について図12を用いて説明する。なお、必要に応じて図11で用いた符号を引用する。

【0123】図12（A）は、発光素子の封止までを行った状態を示す上面図、図12（B）は図12（A）をC-C'で切断した断面図である。点線で示された801はソース側駆動回路、806は画素部、807はゲート側駆動回路である。また、901はカバー材、902は第1シール材、903は第2シール材であり、第1シール材902で囲まれた内側には封止材907が設けられる。

【0124】なお、904はソース側駆動回路801及びゲート側駆動回路807に入力される信号を伝送するための配線であり、外部入力端子となるFPC（フレキシブルプリントサーキット）905からビデオ信号やクロック信号を受け取る。なお、ここではFPCしか図示されていないが、このFPCにはプリント配線基盤（PWB）が取り付けられていても良い。本明細書における発光装置には、発光装置本体だけでなく、それにFPCもしくはPWBが取り付けられた状態をも含むものとする。

【0125】次に、断面構造について図12（B）を用いて説明する。基板700の上方には画素部806、ゲート側駆動回路807が形成されており、画素部806は電流制御TFT604とそのドレインに電気的に接続された画素電極711を含む複数の画素により形成される。また、ゲート側駆動回路807はnチャネル型TFT601とpチャネル型TFT602とを組み合わせたCMOS回路（図14参照）を用いて形成される。

【0126】画素電極711は発光素子の陽極として機能する。また、画素電極711の両端にはバンク712が形成され、画素電極711上には発光層713および発光素子の陰極714が形成される。

【0127】陰極714は全画素に共通の配線としても機能し、接続配線904を経由してFPC905に電気的に接続されている。さらに、画素部806及びゲート側駆動回路807に含まれる素子は全て陰極714およびパッシベーション膜567で覆われている。

10 【0128】また、第1シール材902によりカバー材901が貼り合わされている。なお、カバー材901と発光素子との間隔を確保するために樹脂膜からなるスペーサを設けても良い。そして、第1シール材902の内側には封止材907が充填されている。なお、第1シール材902、封止材907としてはエポキシ系樹脂を用いるのが好ましい。また、第1シール材902はできるだけ水分や酸素を透過しない材料であることが望ましい。さらに、封止材907の内部に吸湿効果をもつ物質や酸化防止効果をもつ物質を含有させても良い。

20 【0129】発光素子を覆うようにして設けられた封止材907はカバー材901を接着するための接着剤としても機能する。また、本実施例ではカバー材901を構成するプラスチック基板901aの材料としてFRP（Fiberglass-Reinforced Plastics）、PVF（ポリビニルフロライド）、マイラー、ポリエステルまたはアクリルを用いることができる。

【0130】また、封止材907を用いてカバー材901を接着した後、封止材907の側面（露呈面）を覆うように第2シール材903を設ける。第2シール材903は第1シール材902と同じ材料を用いることができる。

30 【0131】以上のような構造で発光素子を封止材907に封入することにより、発光素子を外部から完全に遮断することができ、外部から水分や酸素等の発光層の酸化による劣化を促す物質が侵入することを防ぐことができる。従って、信頼性の高い発光装置が得られる。

【0132】以上のようにして作製される発光装置は大粒径の結晶粒を有する半導体膜を用いて作製されており、前記発光装置の動作特性や信頼性を十分なものとなり得る。そして、このような液晶表示装置は各種電子機器の表示部として用いることができる。

【0133】なお、本実施例は実施例1乃至4のいずれか一と自由に組み合わせることが可能である。

【0134】【実施例7】本発明を適用して、様々な電気光学装置（アクティブマトリクス型液晶表示装置、アクティブマトリクス型発光装置、アクティブマトリクス型EC表示装置）を作製することができる。即ち、それら電気光学装置を表示部に組み込んだ様々な電子機器に本発明を適用できる。

【0135】その様な電子機器としては、ビデオカメ

ラ、デジタルカメラ、プロジェクター、ヘッドマウントディスプレイ（ゴーグル型ディスプレイ）、カーナビゲーション、カーステレオ、パーソナルコンピュータ、携帯情報端末（モバイルコンピュータ、携帯電話または電子書籍等）などが挙げられる。それらの例を図13、図14及び図15に示す。

【0136】図13(A)はパーソナルコンピュータであり、本体3001、画像入力部3002、表示部3003、キーボード3004等を含む。本発明を表示部3003に適用することができる。

【0137】図13(B)はビデオカメラであり、本体3101、表示部3102、音声入力部3103、操作スイッチ3104、バッテリー3105、受像部3106等を含む。本発明を表示部3102に適用することができる。

【0138】図13(C)はモバイルコンピュータ（モービルコンピュータ）であり、本体3201、カメラ部3202、受像部3203、操作スイッチ3204、表示部3205等を含む。本発明は表示部3205に適用できる。

【0139】図13(D)はゴーグル型ディスプレイであり、本体3301、表示部3302、アーム部3303等を含む。本発明は表示部3302に適用することができる。

【0140】図13(E)はプログラムを記録した記録媒体（以下、記録媒体と呼ぶ）を用いるプレーヤーであり、本体3401、表示部3402、スピーカ部3403、記録媒体3404、操作スイッチ3405等を含む。なお、このプレーヤーは記録媒体としてDVD(Digital Versatile Disc)、CD等を用い、音楽鑑賞や映画鑑賞やゲームやインターネットを行うことができる。本発明は表示部3402に適用することができる。

【0141】図13(F)はデジタルカメラであり、本体3501、表示部3502、接眼部3503、操作スイッチ3504、受像部（図示しない）等を含む。本発明を表示部3502に適用することができる。

【0142】図14(A)はフロント型プロジェクターであり、投射装置3601、スクリーン3602等を含む。本発明は投射装置3601の一部を構成する液晶表示装置3808やその他の駆動回路に適用することができる。

【0143】図14(B)はリア型プロジェクターであり、本体3701、投射装置3702、ミラー3703、スクリーン3704等を含む。本発明は投射装置3702の一部を構成する液晶表示装置3808や他の駆動回路に適用することができる。

【0144】なお、図14(C)は、図14(A)及び図14(B)中における投射装置3601、3702の構造の一例を示した図である。投射装置3601、37

02は、光源光学系3801、ミラー3802、3804～3806、ダイクロイックミラー3803、プリズム3807、液晶表示装置3808、位相差板3809、投射光学系3810で構成される。投射光学系3810は、投射レンズを含む光学系で構成される。本実施例は三板式の例を示したが、特に限定されず、例えば単板式であってもよい。また、図14(C)中において矢印で示した光路に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相差を調節するためのフィルム、IRフィルム等の光学系を設けてもよい。

【0145】また、図14(D)は、図14(C)中ににおける光源光学系3801の構造の一例を示した図である。本実施例では、光源光学系3801は、リフレクター3811、光源3812、レンズアレイ3813、3814、偏光変換素子3815、集光レンズ3816で構成される。なお、図14(D)に示した光源光学系は一例であって特に限定されない。例えば、光源光学系に実施者が適宜、光学レンズや、偏光機能を有するフィルムや、位相差を調節するフィルム、IRフィルム等の光学系を設けてもよい。

【0146】ただし、図14に示したプロジェクターにおいては、透過型の電気光学装置を用いた場合を示しており、反射型の電気光学装置及び発光装置での適用例は図示していない。

【0147】図15(A)は携帯電話であり、本体3901、音声出力部3902、音声入力部3903、表示部3904、操作スイッチ3905、アンテナ3906等を含む。本発明を表示部3904に適用することができる。

【0148】図15(B)は携帯書籍（電子書籍）であり、本体4001、表示部4002、4003、記憶媒体4004、操作スイッチ4005、アンテナ4006等を含む。本発明は表示部4002、4003に適用することができる。

【0149】図15(C)はディスプレイであり、本体4101、支持台4102、表示部4103等を含む。本発明は表示部4103に適用することができる。本発明のディスプレイは特に大画面化した場合において有利であり、対角10インチ以上（特に30インチ以上）のディスプレイには有利である。

【0150】以上の様に、本発明の適用範囲は極めて広く、さまざま分野の電子機器に適用することが可能である。また、本実施例の電子機器は実施例1～4または5のどのような組み合わせからなる構成を用いても実現することができる。

【0151】

【発明の効果】本発明によれば、レーザアニールの際にレーザ光を矩形状または梢円状に加工してスループットを向上させることを可能とする。延いてはTFTやTFTで形成された液晶表示装置等の半導体装置の製造コス

トを低減することができる。また複数のレーザ（または複数のレーザ光）により、同時に多方向への照射も可能となり、スループットが向上する。

【0152】さらに、半導体膜に対してレーザ光を斜めに照射することで、戻り光、すなわち基板表面からの反射光がレーザ装置に達することが無くなるため、特にレーザ発振機に固体レーザを使う場合には有効である。また、基板をf-θレンズやシリンドリカルレンズに対して、シリンドリカルレンズの母線を軸に回転させ斜めに設置すれば、照射面におけるレーザ光の形状が軸対称性を失わないため、均一なレーザアニールが可能となる。さらに、半導体膜や基板を透過する波長のレーザ光を用いても、基板に入射するレーザ光と基板裏面からの反射光との干渉の影響を低減することができるので、より一様なレーザアニールを行うことができる。このような半導体膜を用いて半導体装置を作製すれば、半導体装置の性能を大幅に向上しうる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 照射面におけるレーザ照射方法の例を示す図。

【図2】 照射面におけるレーザ照射方法の例を示す図。

【図3】 本発明が開示するレーザ照射装置の例を示す

図。

【図4】 本発明が開示するレーザ照射装置の例を示す図。

【図5】 大面積基板に本発明を適用する例を示す図。

【図6】 画素TFT、駆動回路のTFTの作製工程を示す断面図。

【図7】 画素TFT、駆動回路のTFTの作製工程を示す断面図。

【図8】 画素TFT、駆動回路のTFTの作製工程を示す断面図。

【図9】 画素TFTの構成を示す上面図。

【図10】 アクティブマトリクス型液晶表示装置の作製工程を示す断面図。

【図11】 発光装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。

【図12】 (A) 発光装置の上面図。

(B) 発光装置の駆動回路及び画素部の断面構造図。

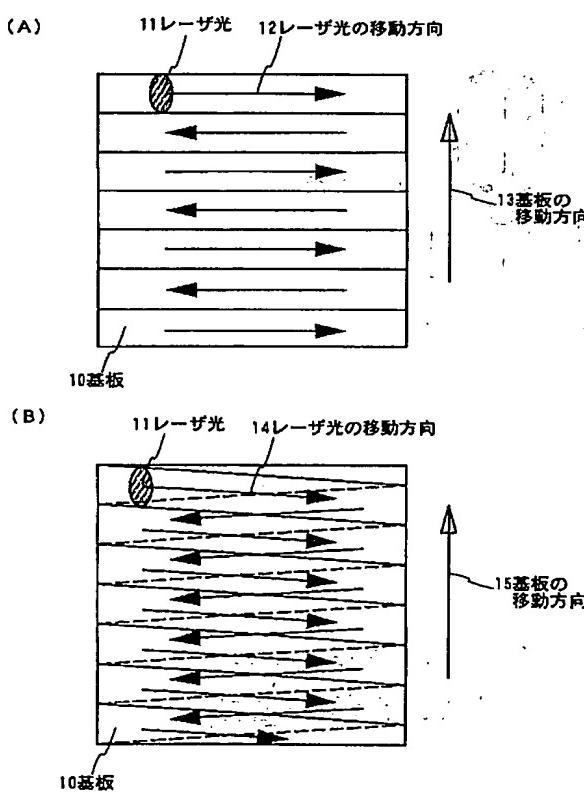
【図13】 半導体装置の例を示す図。

【図14】 半導体装置の例を示す図。

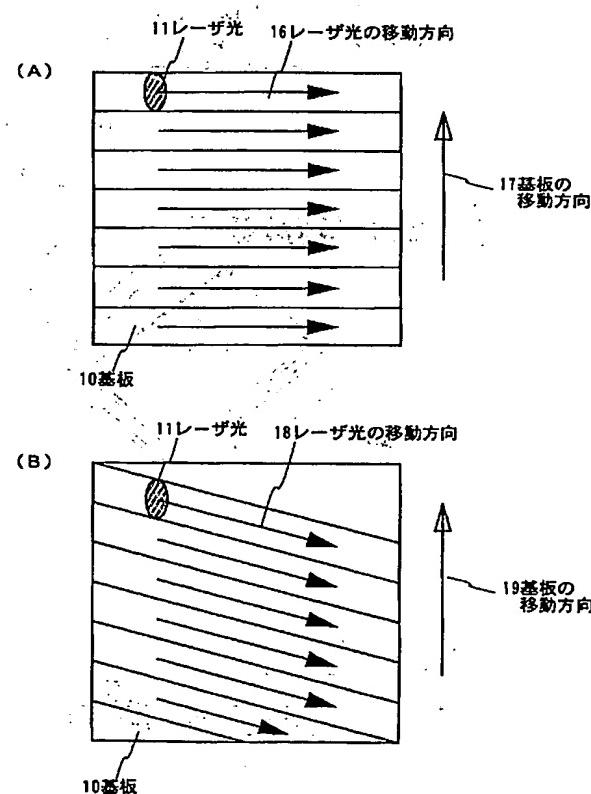
【図15】 半導体装置の例を示す図。

【図16】 本発明が開示するレーザ照射装置の例を示す図。

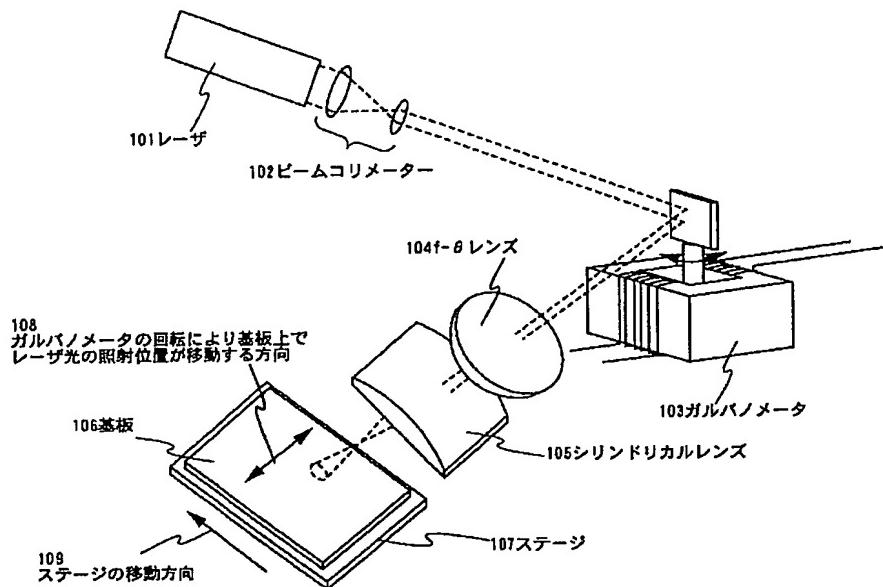
【図1】



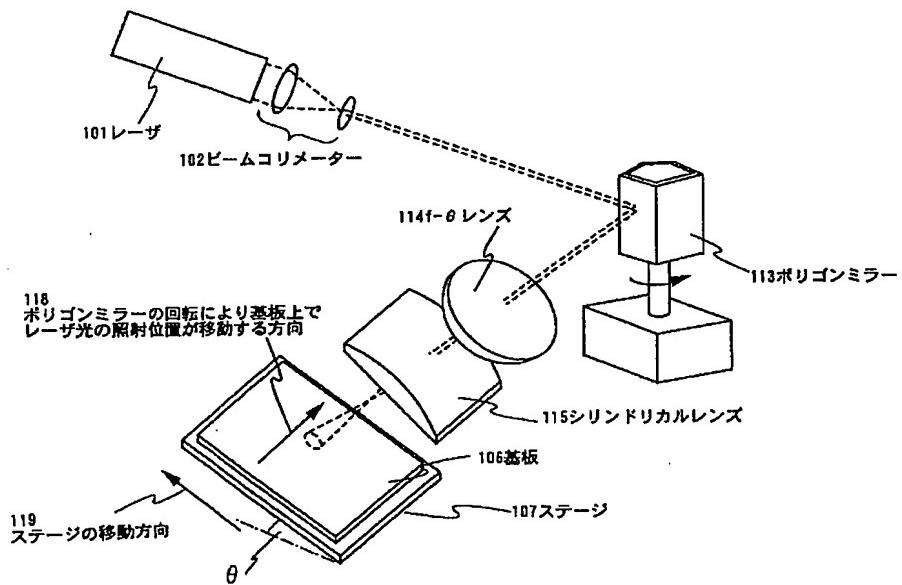
【図2】



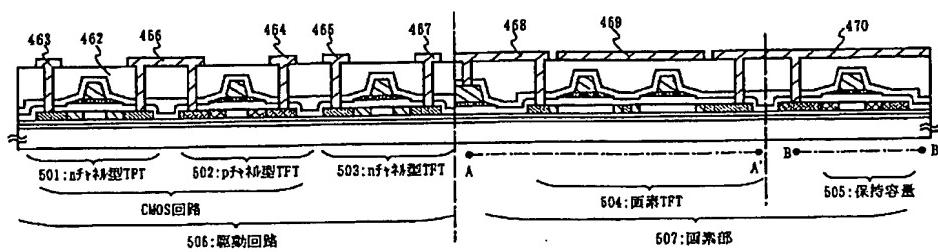
【図 3】



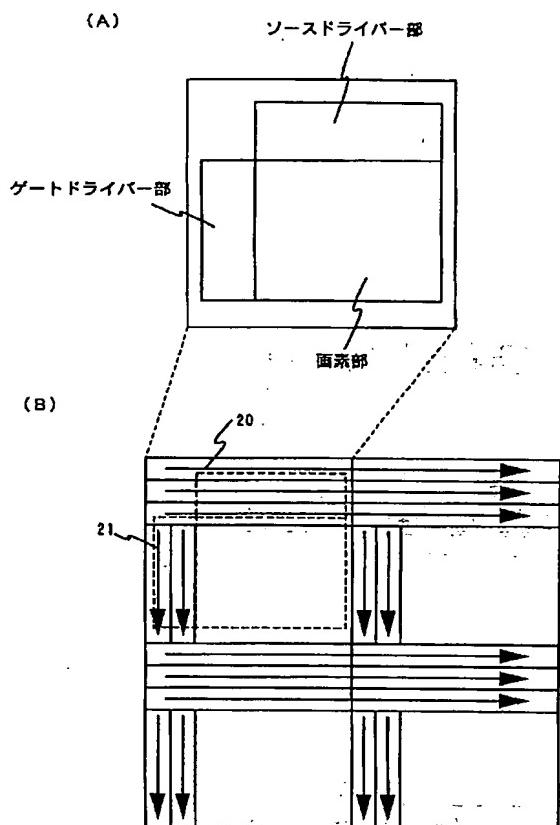
【図 4】



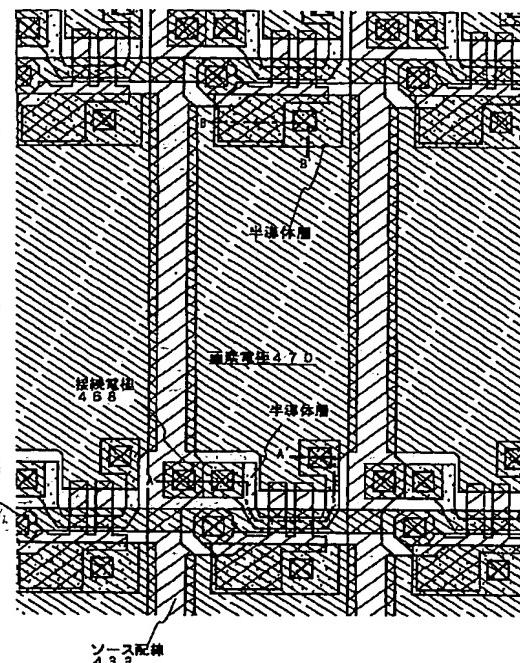
【図 8】



【図5】

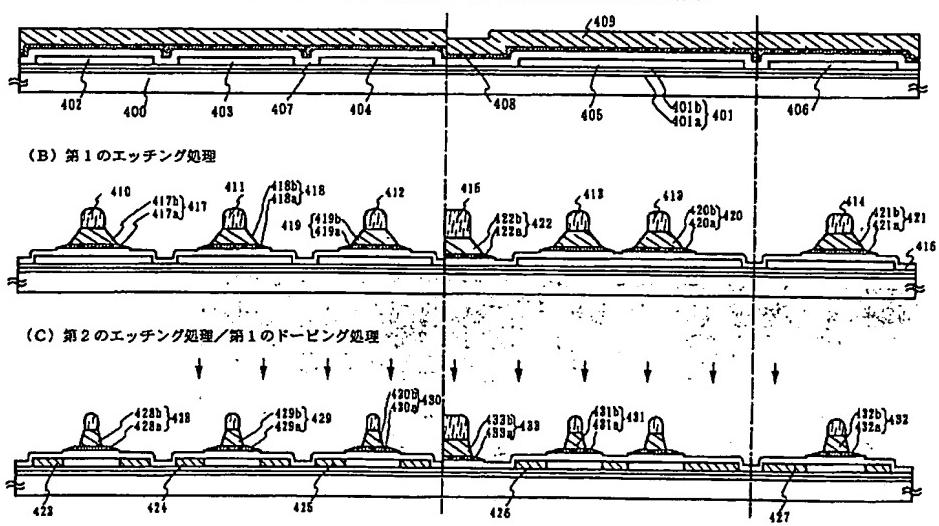


【図9】

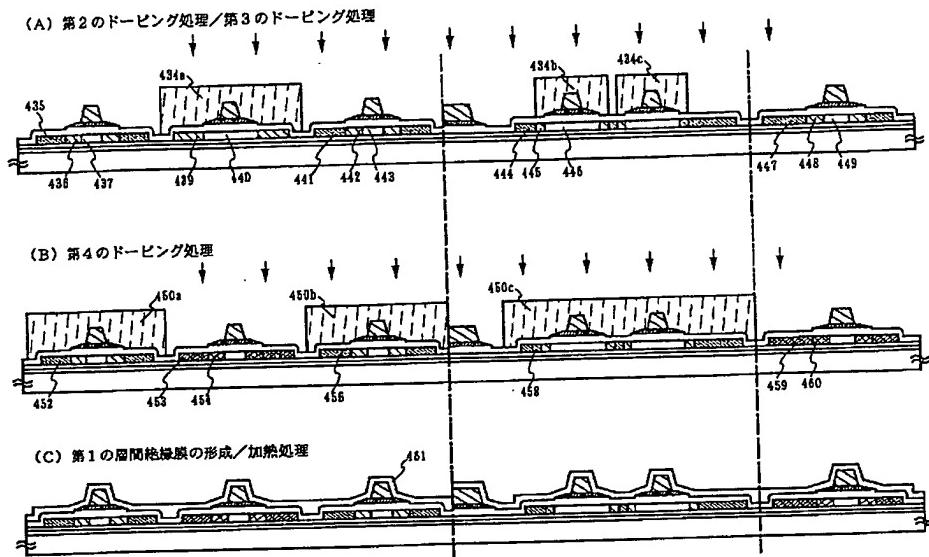


【図6】

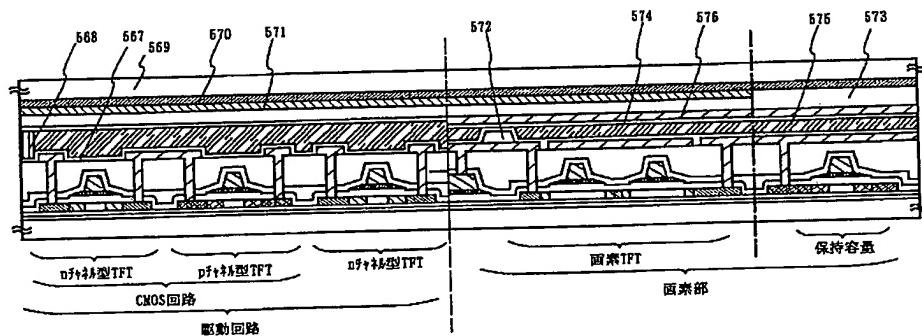
(A) 下地絶縁膜の形成／半導体層の形成／絶縁膜の形成／第1の導電膜および第2の導電膜の形成



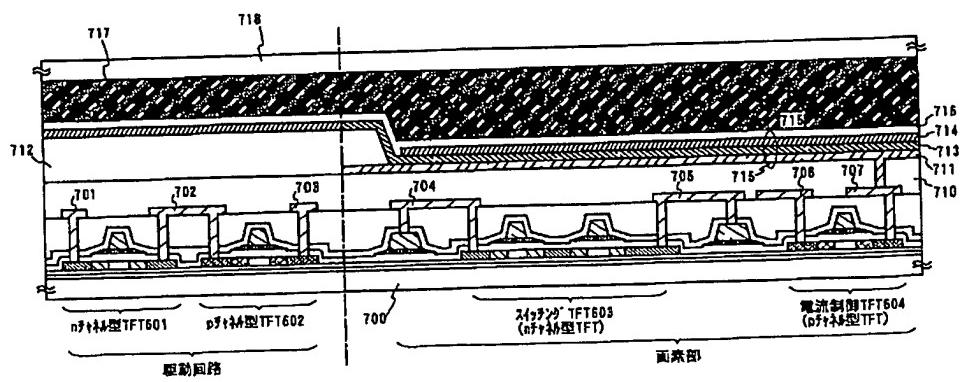
【図 7】



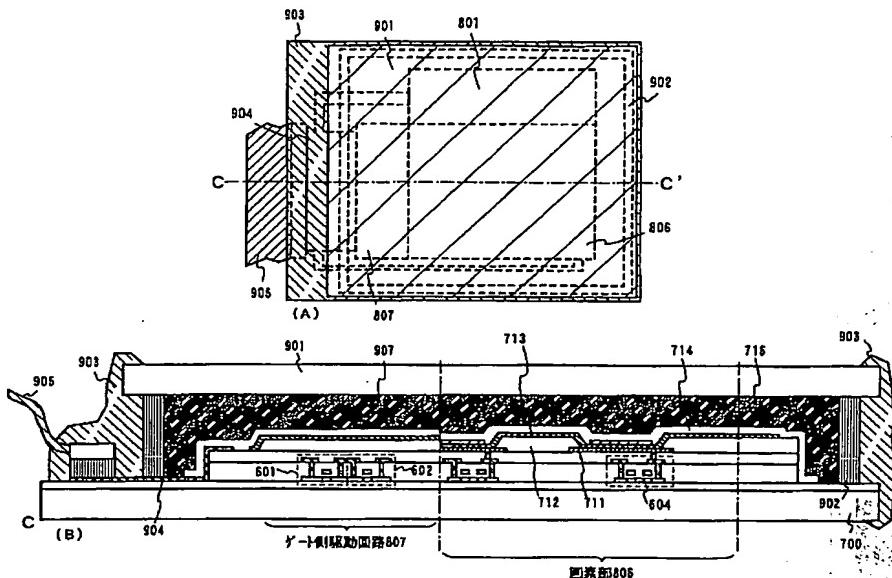
【図 10】



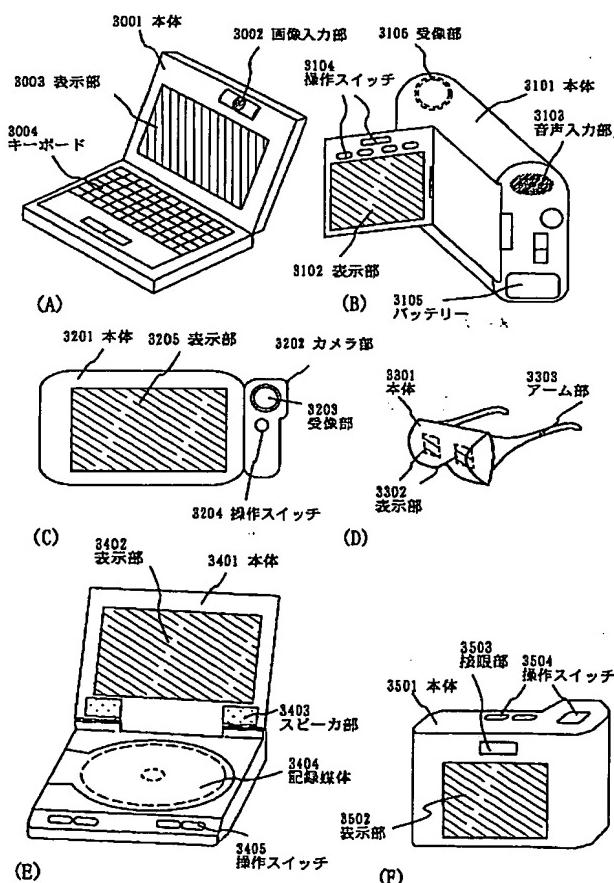
【図 11】



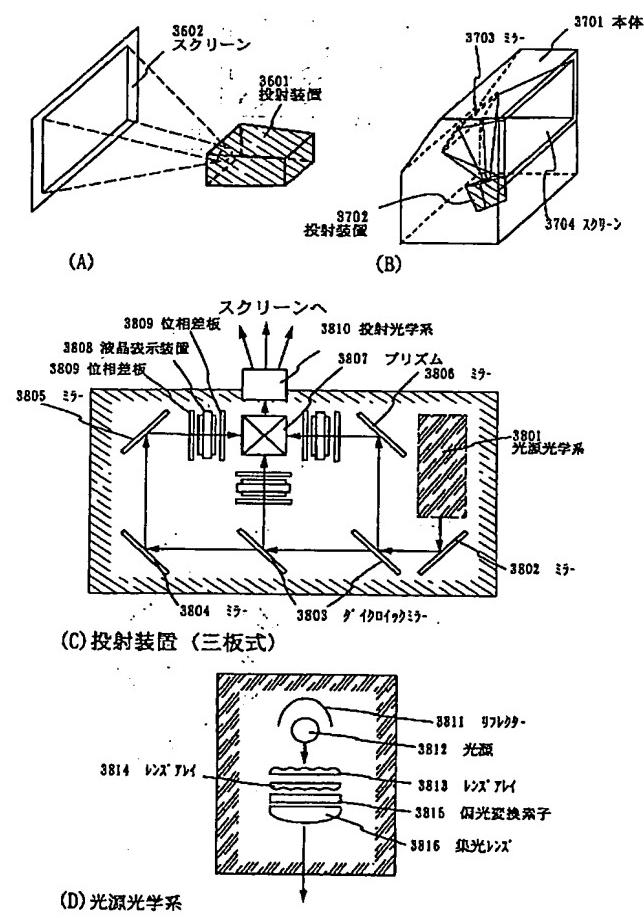
【図12】



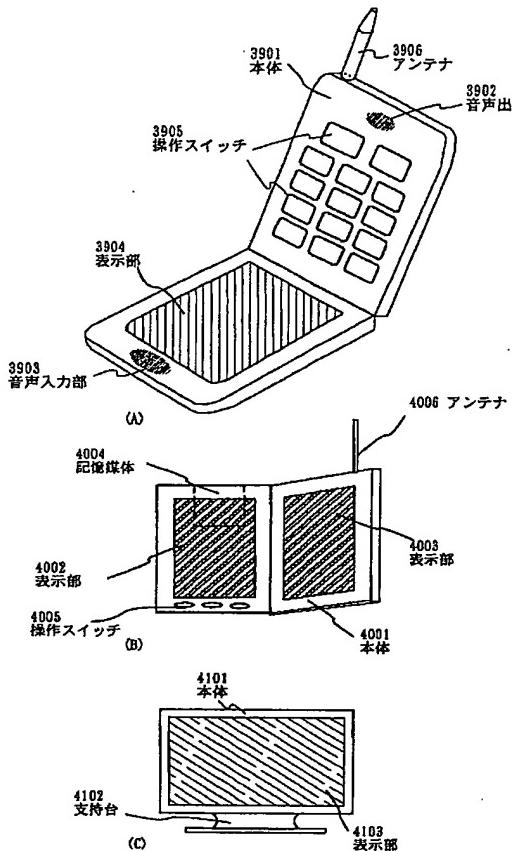
【図13】



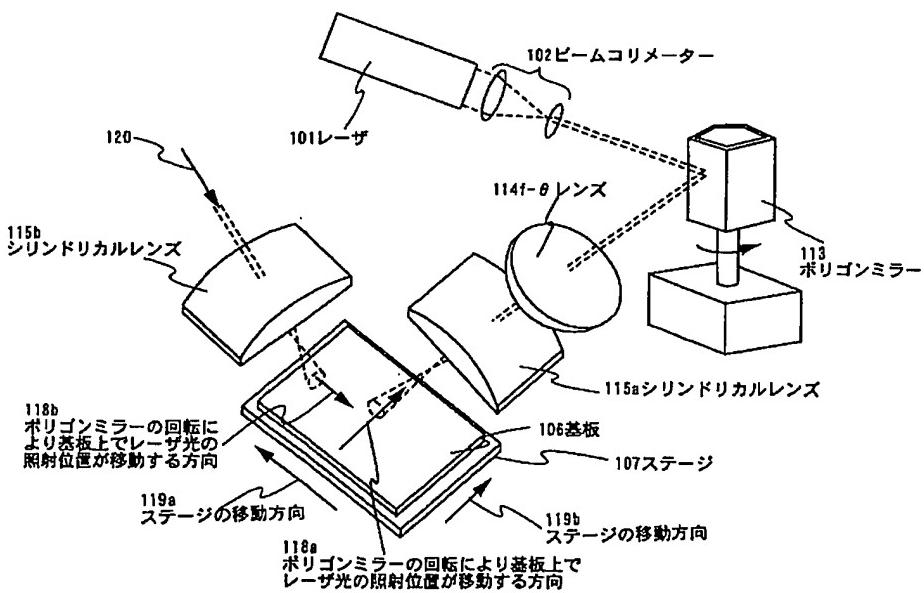
[図 1-4]



【図15】



【図16】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	F I	マークコード(参考)
H 0 1 L 21/20		H 0 1 L 21/20	5 G 4 3 5
21/28		21/28	F
21/336		G 0 9 F 9/00	3 4 8 C
29/786		B 2 3 K 101:40	
// G 0 9 F 9/00	3 4 8	H 0 1 L 29/78	6 2 7 G
B 2 3 K 101:40			

F ターム(参考) 2H092 JA24 KA05 MA30 NA21 NA24
NA27
4E068 CA03 CD05 CD12 CD14 CE03
CE04 DA09
4M104 AA09 BB02 BB04 BB08 BB13
BB14 BB16 BB17 BB18 BB32
CC05 DD42 DD65 FF08 FF17
GG20
5F052 AA02 AA12 AA24 BA04 BA18
BB02 BB05 BB07 DA02 DB02
DB03 DB07 FA06 FA19 JA01
5F110 AA01 AA16 AA28 BB02 BB04
BB05 CC02 DD01 DD02 DD03
DD05 DD13 DD14 DD15 DD17
EE01 EE02 EE03 EE04 EE06
EE09 EE14 EE23 EE28 EE44
EE45 FF02 FF04 FF09 FF28
FF30 GG01 GG02 GG13 GG25
GG32 GG43 GG45 GG47 HJ01
HJ04 HJ12 HJ13 HJ23 HL01
HL02 HL03 HL04 HL06 HL11
HL12 HM15 NN03 NN04 NN22
NN27 NN34 NN35 NN36 PP01
PP02 PP03 PP04 PP05 PP06
PP07 PP24 PP34 QQ04 QQ11
QQ19 QQ23 QQ24 QQ25
5G435 AA17 BB05 CC09 EE37 HH13
KK05 KK10

THIS PAGE BLANK (USPTO)